ROTARY COATER AND ROTARY COATING METHOD

Publication number: JP2001179163 (A)

Publication date: 2001-07-03

Inventor(s): HARUKAWA SUMIO
Applicant(s): HIRATA SPINNING

Classification:

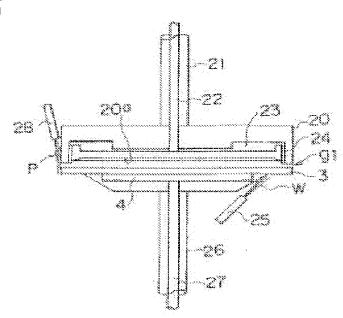
- international: **B05D1/40; B05C11/08; B05D1/40; B05C11/08; B05C11/08; B05C11/08**; B05D1/40

- European:

Application number: JP19990372964 19991228 **Priority number(s):** JP19990372964 19991228

Abstract of JP 2001179163 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rotary coater and a rotary coating method capable of suppressing suspended particles and mist or the like generated in the rotational treatment and preventing sticking to the front and rear surface of a substrate and free from the swelling or infiltrating of the scattered excess liquid on the substrate rear end surface. SOLUTION: The rotary coater is provided with a rotary table 4, a discharge nozzle 28 for discharging a treating liquid to the outer peripheral surface of the substrate 3, a rotary cap body 20 covering the coating film effective surface of the substrate 3 in a non-contact state and rotatively driven, a discharge nozzle 24 for discharging the treating liquid to the edge part and a discharge nozzle 25 for discharging the treating liquid to the edge part of the rear surface of the substrate.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-179163 (P2001-179163A)

(43)公開日 平成13年7月3日(2001.7.3)

| (51) Int.Cl.7 | 識別記号 | FΙ | テーマコート [*] (参考) |
|---------------|-------|---------------|--------------------------|
| B05C | 11/08 | B 0 5 C 11/08 | 3 4D075 |
| B05D | 1/40 | B 0 5 D 1/40 | A 4F042 |

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 9 頁)

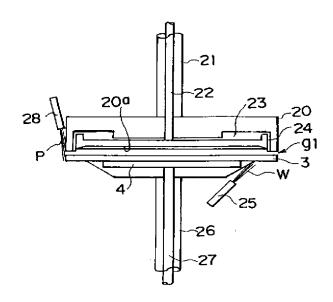
| (21)出願番号 | 特願平11-372964 | (71) 出願人 391032358 | |
|----------|----------------------------|--|--|
| (22)出顧日 | 平成11年12月28日 (1999. 12. 28) | 平田機工株式会社 東京都品川区戸越3丁目9番 (72)発明者 春川 澄夫 東京都品川区戸越3丁目9番 工株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康徳 (外1 Fターム(参考) 4D075 AC06 AC09 AC64 A BB14Z BB20Z BB69 DA35 DB13 DC22 E 4F042 AA07 AA29 CC10 E | 20号 平田機 名) C82 AD20 Z DA08 A07 |
| | | EDIT EDES EDES | |

(54) 【発明の名称】 回転式塗布装置と回転式塗布方法

(57)【要約】

【課題】 回転処理時に発生する浮遊パーティクルおよびミスト等を抑制することができ、基板表裏面に付着しないようにでき、回転処理時に拡散余剰液が基板裏端面に盛り上がったり回り込んだりしない回転式塗布装置と回転式塗布方法の提供。

【解決手段】 回転テーブル4と、基板3の外周面に対して処理液を吐出する吐出ノズル28と、基板3の塗布膜有効表面を非接触で覆うとともに回転駆動される回転蓋体20と、縁部に処理液を吐出する吐出ノズル24と、基板の裏面の縁部に処理液を吐出する吐出ノズル25とを備える。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 円形平面を塗布対象面とした基板に塗布装置により塗布液を塗布して一次塗布膜を形成した後に、高速回転により前記一次塗布膜を拡散させることで均一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要となる過剰塗布膜分が前記二次塗膜側に移動することを防止する回転式塗布装置であって、

処理液を前記基板の外周付近に向けて吐出することで前 記過剰塗布膜分を除去する複数の吐出ノズルから構成さ れる流体カーテン形成手段を備えることを特徴とする回 10 転式塗布装置。

【請求項2】 円形平面を塗布対象面とした基板に塗布装置により塗布液を一次塗布して一次塗布膜を形成した後に、高速回転させて前記一次塗布膜を拡散させ均一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要な塗布膜分を吐出ノズルから処理液を吐出して除去する回転式塗布装置であって、

前記基板を吸引保持し回転駆動する回転テーブルと、 前記基板の外周面に対して処理液を吐出する第1の吐出 ノズルと、

前記基板の塗布膜有効表面を、非接触で覆うとともに昇 降及び回転駆動される回転蓋体と、

前記基板の表面の縁部に処理液を吐出する第2の吐出ノ ズルと

前記基板の裏面の縁部に処理液を吐出する第3の吐出ノ ズルとを備え、

前記第2、第3の吐出ノズルの少なくとも一方は、前記 縁部の近傍に向けて概環状に処理液を吐出するように構 成したことを特徴とする回転処理装置。

【請求項3】 前記第1の吐出ノズルは、前記回転テー 30 ブルの外周部に設けられることを特徴とする請求項2に 記載の回転処理装置。

【請求項4】 前記第3の吐出ノズルは、不動状態に固定される構成体に設けられるとともに、処理液を略環状に吐出する環状ノズルであることを特徴とする請求項2に記載の回転処理装置。

【請求項5】 前記第2の吐出ノズルは、前記回転蓋体に設けられるとともに、前記基板に処理液を環状に吐出するための環状ノズルであることを特徴とする請求項2に記載の回転処理装置。

【請求項6】 前記回転蓋体に設けられた環状ノズルは 基板外形形状に略相似となるように形成されるととも に、前記回転蓋体と前記回転テーブルの回転を同期駆動 する回転手段により制御されることを特徴とする請求項 2乃至5のいずれか1項に記載の回転処理装置。

【請求項7】 円形平面を塗布対象面とした基板に塗布 装置により塗布液を塗布して一次塗布膜を形成した後 に、高速回転により前記一次塗布膜を拡散させることで 均一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要 となる過剰塗布膜分が前記二次塗膜側に移動することを 50

防止する回転式塗布方法であって、

複数の吐出ノズルから構成される流体カーテン形成手段 により処理液を前記基板の外周付近に向けて吐出することで前記過剰塗布膜分を除去する工程を備えることを特 徴とする回転式塗布方法。

【請求項8】 円形平面を塗布対象面とした基板に塗布 装置により塗布液を一次塗布して一次塗布膜を形成した 後に、高速回転させて前記一次塗布膜を拡散させ均一な 薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要な塗布 膜分を吐出ノズルから処理液を吐出し除去して基板塗布 膜を生成する回転処理方法であって、

回転テーブルにより前記基板を吸引保持し回転駆動する 工程と、

環状ノズルから、前記基板の裏端面に処理液を吐出する 工程と

回転蓋体を降下して、前記基板の塗布膜有効表面を非接触状態で覆い回転駆動する工程と、

前記回転蓋体に設けられた環状ノズルから、前記基板の 表端面の外周部に処理液を吐出する工程と、

の 廃液排出手段に連通されるとともに、前記回転蓋体の外 周側に配設される液受け用のカップにより遠心力に伴う 飛散する液を受け排出する工程と、

前記カップの壁面と対向する前記回転蓋体の側壁面の間 に処理液を吐出する工程と、

前記回転蓋体の側壁面と前記カップの壁面で形成される 間隙に処理液を吐出する工程とを備えることを特徴とす る回転処理方法。

【請求項9】 裏端面に処理液を吐出する前記環状ノズルと前記基板との間に概環状の空隙を設け、空隙にガスを供給するとともに、前記空隙内を外部より陽圧に維持し回転する工程と備えることを特徴とする請求項8に記載の回転処理方法。

【請求項10】 前記カップには、カップ内の雰囲気を 吸引排出する工程を設けたことを特徴とする請求項8に 記載の回転処理方法。

【請求項11】 前記環状ノズルの上流に、処理液貯溜部から概均一な処理液吐出を行なう工程と、

前記処理液貯溜部の上流にサックバック用開閉バルブに よる吸引する工程と、

40 処理液供給手段からの供給を開閉バルブにより制御する 工程とを備えることを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の回転処理方法。

【請求項12】 前記基板は一次塗布膜を高速回転して 拡散させ二次膜を形成した後に行われる端縁処理工程で あることを特徴とする請求項8に記載の回転処理方法。

【請求項13】 前記二次塗布膜形成と前記端縁処理工程とが一部もしくは全部が重複するようにしたことを特徴とする請求項8に記載の回転処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

2

3

【発明の属する技術分野】本発明は回転式塗布装置と回転式塗布方法に係り、特に平坦な枚葉部材などの被塗布円形基板の表面に塗布液を吐出し、所望する塗膜を形成する方法に係わり、特に半導体ウェハを高速で回転させ一次塗布膜を拡散し均一な二次薄膜を形成したり、基板の端縁部に付着した塗布液を基板を回転させながら除去する際の回転処理方法およびその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造工程や液晶表示装置の製造工程において半導体基板にレジスト液等を塗布する装置としてスピンコート法がある。スピンコート法は、基板を吸引保持し低速回転させながら円形吐出ノズルや直線的なスリットを備える塗布ヘッドから塗布液を基板上に滴下あるいは移動しつつ塗布する一次塗布を行ない、その後に高速回転して余剰の塗布液を遠心力で拡散、飛散させて所望する均一な二次薄膜を得るようにしている。

【0003】近年になり塗布液の消費量を抑制するための省液塗布方法が数多く提案され開発されているが、上記の遠心力による回転処理方法を採用する以上、余剰塗布液の飛散を避けることはできない。そこで、余剰塗布液の飛散を避けることはできない。そこで、余剰塗布液が装置外へ飛散しないために飛散液を受け止めるためのカップを回転駆動される基板外周に配置している。このカップは、高速回転し飛散してくる塗布液や基板端縁部の不要塗布膜を除去するための処理液を受け止めるので飛散液で汚染される。また、カップに付着した塗布液が固化するとパーティクルが発生し、空中に浮遊するようになる。また、カップに飛散液が衝突し、パーティクルやミストを発生させる。さらに、基板を高速回転させると乱流が発生し、浮遊するパーティクルやミストが基板に再付着する問題がある。30

【0004】一方、一次塗布された塗布膜を高速回転で 振切ると二次塗布膜を形成することができるが、最終的 に振切ることが出来ずに、基板端部に流れた余剰液につ いては、表面張力の作用で基板端縁部で盛り上がり、基 板裏面まで回り込んだ状態になる。このように高速回転 後の端縁部に盛り上がって付着した状態の塗布液は、パーティクルの発生源となるばかりか、その後のプロセス 工程に様々な悪影響を及ぼす。また、塗布液は速乾性溶 液を溶媒としているので固化し易く、固化が進むと除去 し難い。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、端縁除去の一般的な方法としては、回転駆動される基板表裏の各々の端面部から基板外側に向けて処理液が流れるように処理液吐出ノズルを配置して除去する方法が採用されている。しかし、高速回転により除去された液は飛散しカップに衝突し、バーティクルやミストを発生させることになる。また、低速回転にしたり吐出量が多すぎると基板に吐出した処理液が基板有効面に流れてしまい、基板にダメージを与えることになる。

【0006】さらに、従来の処理方法では、高速回転して余剰塗布液を振切りった後に、低速回転させて除去作業を行なうようにしていたために、スループットの向上には限界が有った。

4

【0007】また、基板のサイズ、種々の処理液とその特性(粘性、溶媒蒸発速度)、二次膜形成後除去に到るまでの時間、乾燥具合、吐出処理液の種類、吐出速度、吐出方向、吐出量、吐出ノズルと基板表面の距離、吐出角度、除去空間の温度や湿度、回転速度と飛散液の遠心力、カップ衝突壁面までの距離、壁面衝突角度、回転に伴う乱流の発生具合、これら様々な影響因子を、各工程毎に定められたサイクルタイム内で、基板表面だけでなく端面裏面も含む基板全体をバーティクルやミストが付着しないように処理することが求められている。

【0008】高速回転時に振切った飛散液がカップ壁面に衝突し、その際発生するパーティクルやミストからウェハに再付着を抑制する方法としてさまざまな提案がこれまでに開示されてきた。また、ウェハ端縁の余剰液洗浄除去工程において発生する浮遊パーティクルや浮遊ミストからの汚染からウェハを保護することも大きな課題である。

【0009】特開平9-122558号公報に開示され たオープンカップ方式の塗布方法は、浮遊するバーティ クルやミストがウェハ上面に付着しないように、気流を 利用するもので、従来のウェハ上面から下面方向へ流れ るような気流だけでは十分とはいえず、回転する環状プ レートを設けることによりパーティクルの再付着を抑制 しようというものである。また、特開平8-29009 4号公報を引用すると、ウェハ上面を完全に蓋体で覆い ウェハとともに蓋体を回転させるクローズドカップ方式 は、回転終了時に蓋体を開放する際の外部の塵埃流入が 問題であり、その改善案が示されている。また、特開平 5-305261号公報に記載の内容は、飛散量が多い 従来の塗布方法では余剰液が固化しドレンパイプを破損 する可能性を指摘している。端縁除去方法においては、 特公平3-76777号公報や特開平6-45320号 公報に開示されており、回転する基板に洗浄処理液吐出 ノズルを表裏端部に望ませ吐出すると同時に端面を機械 的に擦る機構を採用して除去している。

0 【0010】また、特開平5-166720号公報には ノズルから吐出する洗浄液を吸引し排出するようにした り、また特開平9-308868号公報には基板端縁を 所定時間、洗浄用除去溶剤に浸して端縁部の余分な付着 物を溶解する除去方法等が開示されている。

【0011】したがって、本発明は上記の問題点に鑑みて成されたものであり、回転処理時に発生する浮遊バーティクルおよびミスト等を抑制することができ、基板表裏面に付着しないようにでき、回転処理時に拡散余剰液が基板裏端面に盛り上がったり回り込んだりしないようにすることができ、余剰飛散液を受けるカップ内面が飛

散液で固化することを抑制でき、塗布処理作業終了後、 クリーンな雰囲気環境下でウェハを開放し、パーティク ル汚染から防止することができる回転式塗布装置と回転 式塗布方法の提供を目的としている。

【0012】また、加えて、余剰液を振りきる際に発生するパーティクルを抑制し発生させずに所望する均一薄膜の基板を生成でき、かつ基板端縁部の除去も行ない、基板であるウェハ表面、および裏面へのパーティクル付着を防止し、省スベース(フットブリント)で、高スループットを実現できる回転式塗布装置と回転式塗布方法 10の提供を目的としている。

[0013]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決し、目的を達成するために、本発明によれば、円形平面を塗布対象面とした基板に塗布装置により塗布液を塗布して一次塗布膜を形成した後に、高速回転により前記一次塗布膜を拡散させることで均一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要となる過剰塗布膜分が前記二次塗膜側に移動することを防止する回転式塗布装置であって、処理液を前記基板の外周付近に向けて吐出することで前記過剰塗布膜分を除去する複数の吐出ノズルから構成される流体カーテン形成手段を備えることを特徴としている。

【0014】また、円形平面を塗布対象面とした基板に 塗布装置により塗布液を一次塗布して一次塗布膜を形成 した後に、高速回転させて前記一次塗布膜を拡散させ均 一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要な 塗布膜分を吐出ノズルから処理液を吐出して除去する回 転式塗布装置であって、前記基板を吸引保持し回転駆動 する回転テーブルと、前記基板の外周面に対して処理液 を吐出する第1の吐出ノズルと、前記基板の塗布膜有効 表面を、非接触で覆うとともに昇降及び回転駆動される 回転蓋体と、前記基板の表面の縁部に処理液を吐出する 第2の吐出ノズルと、前記基板の裏面の縁部に処理液を 吐出する第3の吐出ノズルとを備え、前記第2、第3の 吐出ノズルの少なくとも一方は、前記縁部の近傍に向け て概環状に処理液を吐出するように構成したことを特徴 としている。

【0015】また、円形平面を塗布対象面とした基板に 塗布装置により塗布液を塗布して一次塗布膜を形成した 40 後に、高速回転により前記一次塗布膜を拡散させること で均一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不 要となる過剰塗布膜分が前記二次塗膜側に移動すること を防止する回転式塗布方法であって、複数の吐出ノズル から構成される流体カーテン形成手段により処理液を前 記基板の外周付近に向けて吐出することで前記過剰塗布 膜分を除去する工程を備えることを特徴としている。

【0016】また、円形平面を塗布対象面とした基板に 塗布装置により塗布液を一次塗布して一次塗布膜を形成 した後に、高速回転させて前記一次塗布膜を拡散させ均 50

一な薄膜の二次塗布膜を形成するときに発生する不要な 塗布膜分を吐出ノズルから処理液を吐出し除去して基板 塗布膜を生成する回転処理方法であって、 回転テーブ ルにより前記基板を吸引保持し回転駆動する工程と、環 状ノズルから、前記基板の裏端面に処理液を吐出する工程と、回転蓋体を降下して、前記基板の塗布膜有効表面 を非接触状態で覆い回転駆動する工程と、前記回転蓋体 に設けられた環状ノズルから、前記基板の表端面の外周 部に処理液を吐出する工程と、廃液排出手段に連通され るとともに、前記回転蓋体の外周側に配設される液受け 用のカップにより遠心力に伴う飛散する液を受け排出す る工程と、前記カップの壁面と対向する前記回転蓋体の 側壁面の間に処理液を吐出する工程と、前記回転蓋体の 側壁面の間に処理液を吐出する工程と、前記回転蓋体の 側壁面と前記カップの壁面で形成される間隙に処理液を 吐出する工程とを備えることを特徴としている。

6

[0017]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の好適な各実施形態について添付図面を参照して述べる。

【0018】図1は、回転式塗布装置1の全体構成を示 した外観斜視図である。本図において、半導体基板や液 晶硝子基板やプリント基板およびプラズマディスプレイ 等に用いられる平面な基板3は、図示のように一対のフ ォーク16上に載置された状態で回転式塗布装置1と別 の装置間でやり取りされ、所望の塗膜が形成される。こ の装置1の基部2上には、モータ11の本体側が固定さ れている。このモータ11の出力軸か、または不図示の モータから動力を受けることで矢印方向に低速と高速と で回転駆動される回転テーブル4が装置1の上方に開口 するように設けられている。この回転テーブル4は、図 示のように平らな円形の吸着面を有しており、その吸着 面上において真空発生装置15からバルブ14を介して 真空圧を供給することで基板3を吸引保持する無数の吸 着孔4aが設けられている。また、この回転テーブル4 は上下方向に昇降可能であり、基部2に固定される昇降 モータ12の昇降動作で行なう。以上の構成により、回 転テーブル4上に基板3を吸着保持して、矢印方向に移 動されつつ所定塗布液を供給する塗布ヘッド5に対して 相対的に昇降するようにして、一次塗布を行なう。尚、 この一次塗布は、回転する基板の中央部に塗布液を吐出 する細孔ノズル (不図示) により行なうようにしても良

【0019】その後に、塗布ヘッド5を退避させてから、回転蓋体20を基板3上に移動し、二次塗布を行なうように構成されている。この回転蓋体20は回転軸21を回転中心としており、回転テーブルと同時に回転できるように構成されており、さらにこの回転蓋体20には、処理液供給装置6からバルブ7を介して供給される処理液を導入する配管となる流路22と、供給後に強制的に処理液を吸引するサックバルブ8に接続された流路22が設けられており、後述する処理を可能にしてい

る。以上の各バルブとモータは制御装置10に接続されており、制御装置10からの指示に基づき連動して動作できるように構成されている。

【0020】次に、図2は、図1の回転中心軸に沿う断面図であって第1の実施形態を示した図である。本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、本図において基板3は上記の一次塗布され、その基板裏面を回転テーブルで吸引保持している。

【0021】また、回転蓋体20は、基板表面の上に非 10接触状態で位置されており、この状態で処理液を下方から噴射するために不図示の基部に固定されている吐出ノズル25と吐出ノズル28とによりそれぞれ基板3の表端面と裏端面の洗浄処理を行なうように構成されている

【0022】一方、回転蓋体20の中央に位置する回転軸21の中央には処理液流路22が設けられており、この蓋体20の外周部において基板3の表面に処理液を環状に吐出する環状ノズル24が設けられている。また、この環状ノズル24に概均一に処理液を供給するためのリザーバー部23がこの環状ノズル24の上流側に設けられている。以上のように構成することで、環状ノズル24とリザーバー部23を連通する流路を環状の流路にしている。ここで、リザーバー部23と回転軸21を連通する流路22は、均等に複数の溝内に配置することが好ましい。

【0023】以上のような構成とすることで、回転蓋体20を回転駆動しているときに、一定圧力で圧送された希釈溶剤を含む処理液が一旦、リザーバー部23に貯溜される。このリザーバー部23と環状ノスル24を連通30する流路は狭い間隙の環状流路にすることで環状ノズル部24へ均一な量を供給することが可能となる。その吐出される量は、塗布液の種類、塗布膜の厚み、固化の状況等を勘案して、適宜設定されることから、供給装置6に流量調整手段を設けると良い。

【0024】また、吐出ノズル25、28の先端から吐出される処理液はその量にもよるが、基板3の内側には止まらぬよう、また進入しないように遠心力で基板3の外部へ排出されるようにその吐出量が設定される。また、図2に図示のように基板3と回転蓋体20との間の間隙g1を比較的に広く設定し、処理液の吐出量を少なくすると、処理液は回転蓋体20の表面を流れて基板3の表面に接液しないようにできるので、基板表面と蓋体表面の間隙g1の設定は重要である。

【0025】また、基板への塗布を完了し、基板3を上記のようにフォークでアンローディングするとき、回転蓋体から残った処理液が基板3上に落下しないように量を適宜設定する必要がある。

【0026】以上の構成において、2次塗膜形成のため に基板3を高速回転させ均数μm以下の均一薄膜を得る 50

ためには、環状ノズル24のスリットおよびリザーバー 部23からスリットまでの環状流路の間隙を0.5mm 以下、好ましくは $0.1\sim0.3mm$ 前後に設定される。また、環状ノズル24のスリット間隙を環状流路の間隙に比較してより狭くするとより効果的となる。

8

【0.027】また、基板3と回転蓋体20の間隙 g1は $0.2\sim0.4$ mm前後に設定し、何回か処理作業を繰り返しながら処理液の流量を調整することで、所望する基板処理の設定条件を得ることができる。

【0028】さらに、環状ノズル24の内側に位置する基板部位と対向する回転蓋体20の表面部位は、図示のように外周部より凹状の凹部20aとすることで、環状ノズル24のスリット部から吐出した処理液が基板内側へ進入することを防止できるようになる。また、蓋体20から基板への残液の落下対策は、蓋体20内部への処理液供給開閉弁7を閉じ、その下流に設けたサックバック開閉弁8を開き、吸引することで、環状スリットおよび環状流路の液をリザーバー部23に引き込むことができる。また、蓋体表面に付着した処理液については、遠心力を利用し振切ることができるが、処理液は速乾性(揮発性)溶剤であると基板3への処理液の付着を防止できる。

【0029】以上説明した構成にすると、基板表面と蓋体表面と吐出流体とで形成される空間は、あたかも流体シールを形成しながら処理を行なうようになるので、回転処理中に基板表面がパーティクルやミストで汚染されることはない。また、基板と蓋体で形成される空間内のガスは回転蓋体と供回りするので乱流が発生しないので、乾燥していない状態の塗布膜を乱すこともない。以上のように形成される流体シールにより、回転処理中の基板表面に外部空間に浮遊するパーティクルやミストが再付着することを防止できるようになる。

【0030】次に、図3は、図1の回転中心軸に沿う断面図であって、第2の実施形態を示した図である。

【0031】本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、その特徴は、図示のように環状ノズル33を、回転テーブル4の外周部に設けてあり、基板3の裏端面に処理液を略環状に吐出するように構成されている。また、回転テーブル4の保持部の外周面に段差部を設けて、基板3との裏面との間で間隙g2を形成する。また、環状ノズル22には環状リザーバー部32が連通されており、供給管30を回転軸26内に設けて内側を基板吸引用に、その外側を処理液供給管とした二重構造になっている。また、供給管からリザーバー部32までは、対称に配置した複数の溝としてある。さらに、この間隙g2は1mm以下で好ましくは0.5mm以下とする。処理液は圧送手段(不図示)により圧送供給され、供給流路に設けた開閉弁で供給、停止の制御が行なわれる。

【0032】また、回転蓋体20の縁部にかけて図示の

ような傾斜面が形成されており、この傾斜面に沿うように処理液を噴射する吐出ノズル34が設けられており、 基板3の外周縁部に向けて処理液を噴射するようにしている。

9

【0033】以上のように構成することで、2次塗布のために高速回転処理中にパーティクルやミストで基板裏面が汚染されることが防止される。

【0034】次に、図4は、図1の回転中心軸に沿う断面図であって、第3の実施形態を示した図である。本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符 10号を附して説明を割愛すると、その特徴は、図示のように環状ノズル37は、不図示の基部上に不動状態で固定される構成体35に設けられており、基板3の裏端面に処理液を略環状に吐出することを特徴としている。

【0035】図4において、環状ノズル37およびその 構成体35は固定されており、回転する基板3に環状ノ ズル37から吐出された処理液は基板裏面と構成体35 上面との間隙部g2に広がることになり、基板の高速回 転により裏面洗浄を行なうための処理液は基板外へ遠心 力で振切ることが出来るようになる。このために、処理 20 液は供給手段(不図示)により、随時リザーバー部36 に供給される。また、洗浄処理終了時は供給開閉弁(不 図示)を閉じ吐出を停止する。その際に、サックバック 機構を設け構成体35の上面に吐出された処理液を環状 ノズル37内に引き込むようにすることが望ましい。ま た、回転テーブル4の回転を停止させるまでは、環状構 成体と回転テーブル4等で形成される空間部K1を正圧 (陽圧) にしておくと、処理液が内部方向に向かうこと も防止できるようになる。また、基板3と構成体35の 上面との間の間隙 g 2 は 1 mm以下であり、省液洗浄の 30 観点から好ましい間隙は0.5mm以下に設定される。 【0036】以上のように構成することで、基板裏面は 汚染されること無く、2次塗布のための高速回転処理が 可能となる。

【0037】続いて、図5は、図1の回転中心軸に沿う断面図であって、第4の実施形態を示した図である。本図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、その特徴は、図示のように固定される構成体35に設けられ、基板3の裏端面に処理液を略環状に吐出するための環状ノズル37と、回転蓋体20に設けられ、基板3の表端面に処理液を環状に吐出する環状ノズル24を設けたことを特徴としている。

【0038】図5に示すようにすると、基板3の表裏の 端面部に設けられた各々の環状ノズル24、37から処理液を同じように吐出することにより流体シールが形成 されるので、回転処理中に基板の表裏がパーティクルや ミストで汚染されることがなくなる。なお、図5の事例 は、図2に示した上部機構と図4に示した下部機構で構 成したものであるが、図2の上部と図3の下部機構との 組み合わせも可能である。

【0039】図2から図5に示した吐出ノズルは、回転駆動される基板3に対して、処理液を吐出して縁部や、回転蓋体20の側面部を処理するためのものであった。また吐出ノズルは複数個設置することも可能で、それらの幾つかは、回転蓋体20の側面に向けて洗浄するようにすると、基板表裏面および縁部だけでなく蓋体側面部も同時に洗浄し、処理液を振切ることができる。回転処理後の蓋体を動作(上昇)させ基板をアンローディングするとき、汚染されていない蓋体を提供できるので基板にパーティクルが付着する可能性を抑制することができる。

【0040】そして、図6は、図1の回転中心軸に沿う断面図であって、第5の実施形態を示した図である。また、図7は、この第5の実施形態の装置の動作説明例を示したフローチャートである。両図において、既に説明済みの構成部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、その特徴は、図示のように回転駆動される基板3の縁部を処理するための吐出ノズル28を設けている点である。回転蓋体20に設けた略環状ノズル24は基板3の外形形状に略相似とし、回転蓋体20と回転テーブル4の回転を同期するように回転手段を制御するように構成されている。

【0041】図6において、基板3の裏面および固定カップ51の壁面と環状ノズル37を設けた構成体と固定ベース50等で空間K3が形成される。また、飛散液や余剰液を貯溜し排出するために回転蓋体20と基板3との間で空間K2が形成され、固定カップ51の壁面と回転蓋体20の側壁面で空間K4が形成され、基板表面と蓋体内表面で空間K2が、外気空間Kが形成される。

【0042】回転処理中の空間K1は空間K3と環状ノズル37から吐出される処理液で遮断できる。同様に空間K2と空間K3は環状ノズル24から吐出される処理液でシールされ遮断できるようにしている。さらに回転蓋体20とカップ壁面とで形成される空間K4には、処理液が全周に行き渡るように、間隙gを狭く設定している。

【0043】回転処理中のこれらの吐出ノズルから処理液を吐出すると、空間K2および空間K3は、他の空間から完全に遮断することが可能となる。

【0044】また空間K4に処理液が全域に行き渡るようにすると、空間K2空間K3を遮断することが可能である。

【0045】ここで空間K1に陽圧の清浄ガスを供給して、空間K3の廃液を排出するように構成し、さらに空間K3の雰囲気を吸引するようにすると、回転処理中の汚染された空間K3の雰囲気は他の空間を汚染すること無く外部に排出できることになる。

は、図2に示した上部機構と図4に示した下部機構で構 【0046】また、カップ51と回転蓋体20の側面の成したものであるが、図2の上部と図3の下部機構との 50 間の間隙 g は、処理液の消費を抑制するためにも1mm

以下とし、好ましくは 0.5 mm以下とすると良い。また、空間 K 4 から流れ伝わる処理液や環状ノズル 2 4 から流れ振切られる処理液は基板 3 の端部を濡らすような形状にする。さらに、基板縁とカップ壁面の間隙を 1 mm前後に設定することで、効果的な縁部処理が可能となる。

11

【0047】次に、回転処理終了時の動作は、基板端縁の洗浄(回転処理)を完了させると各吐出ノズルの処理液吐出を停止するが、各ノズルにはサックバック弁機能が接続されておりノズル近傍の処理液を内部に吸引する 10 ことができるようにしているが、この際、回転テーブル4や回転蓋体20は回転を続け、特に回転蓋体の下面や側面に付着した液を振切るようにする。

【0048】またその間、空間K1へは清浄空気を供給し、空間K3の排気手段は吸引を続ける。この結果、基板表裏の端縁部および回転蓋体は、洗浄され乾燥させることができることになる。また、空間K3の吸引を続行しながら蓋体20を上昇させる。蓋体内部の空間には空間Kからの清浄空気が流入するようにしている。

【0049】基板着脱のために回転テーブル4が上昇されるが、このとき空間K1およびK3には空間Kの清浄空気が流入するようになる。その後に空間K1への清浄ガス供給を停止し、空間K3の吸引を停止する。

【0050】すなわち、基板の裏端面や縁部ともに飛散 した余剰塗膜分で汚染された環境に触れることはなくな ス

【0051】また、蓋体を上昇させるとき清浄ガスが空間K2に流れるように蓋体に連通させる連通孔を設けていても良い。空間K3の壁面間隙を2mm前後に設定し、下部に貯溜溝を構成するようにすると、各ノズルか 30ら吐出された処理液が各壁面を伝わり流れるので、各壁面は回転処理中、常に洗浄されている状況となる。即ち、空間K3および空間K4を形成する壁面も汚染されない状態を得ることができる。

【0052】以上説明の装置によれば、一次塗膜、二次 塗膜を同じ装置で実施するが、または前工程で別の装置 により一次塗膜を形成したものを搬送してもよいが、図 7において、ステップS1で、回転テーブル4に基板3 を吸着保持し、ステップS2で回転蓋体20を移動して 図6に図示の状態にする。これに続き、各ノズルへの処 40 理液供給が行われて流体シールを形成し、これに前後し て空間K1内が陽圧にされ、かつまた空間K3内が陰圧 に維持される。続く、ステップS5では回転テーブル4 が高速回転駆動されて、遠心力で一次塗膜を基板3の外 周側に拡散して均一厚さの二次塗膜を形成する一方で、 余剰塗膜分を処理液で溶融しつつ廃液として排出する。 所定時間分の高速回転が行われて二次塗膜の形成が終了 したとステップS7で判断されると、ステップS8に進 み処理液供給が解除されて流体シールを解除する。これ に前後してステップS9で上記のように陰陽圧を順次解 50 除してステップS10において回転テーブル4を停止する。その後、ステップS11で回転蓋体20を待機位置に移動し、ステップS12でフォーク移動と回転テーブルの降下動作で基板3を装置外部に取出す。

12

【0053】尚、塗布対象基板は二次塗布膜形成過程と 端縁処理工程とが一部もしくは全部が重複するようにす ることで、基板を汚染すること無く、塗布液拡散工程と 基板端縁処理工程を同時に行なうことができることか ら、歩留まりや生産性の向上に大いに貢献できるように なる。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、回転処理時に発生する浮遊パーティクルおよびミスト等を抑制することができ、基板表裏面に付着しないようにでき、回転処理時に拡散余剰液が基板裏端面に盛り上がったり回り込んだりしないようにすることができ、余剰飛散液を受けるカップ内面が飛散液で固化することを抑制でき、塗布処理作業終了後、クリーンな雰囲気環境下でウェハを開放し、パーティクル汚染から防止することができる回転式塗布装置と回転式塗布方法を提供できる

【0055】加えて、余剰液を振りきる際に発生するパーティクルを抑制し発生させずに所望する均一薄膜の基板を生成でき、かつ基板端縁部の除去も行ない、基板であるウェハ表面、および裏面へのパーティクル付着を防止し、省スペース(フットブリント)で、高スルーブットを実現できる回転式塗布装置と回転式塗布方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

) 【図1】各実施形態に共通する回転式塗布装置1の外観 斜視図である。

【図2】図1の回転テーブル4の回転中心軸に沿う断面 図であって第1の実施形態を示した図である。

【図3】図1の回転テーブル4の回転中心軸に沿う断面図であって第2の実施形態を示した図である。

【図4】図1の回転テーブル4の回転中心軸に沿う断面図であって第3の実施形態を示した図である。

【図5】図1の回転テーブル4の回転中心軸に沿う断面 図であって第4の実施形態を示した図である。

【図6】図1の回転テーブル4の回転中心軸に沿う断面 図であって第5の実施形態を示した図である。

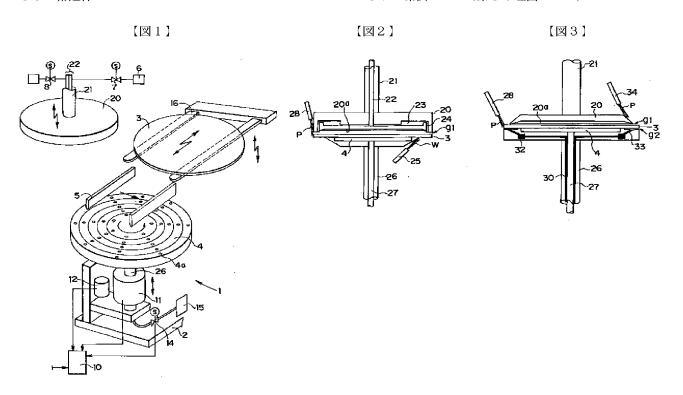
【図7】動作説明のフローチャートである。 【符号の説明】

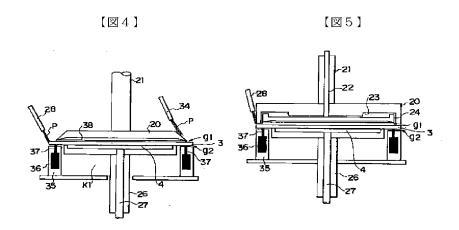
1 回転式塗布装置

- 9 其部
- 3 基板
- 4 回転テーブル
- 5 塗布ヘッド
- 24 環状ノズル(第2の吐出ノズル)
- 28 吐出ノズル (第1の吐出ノズル)

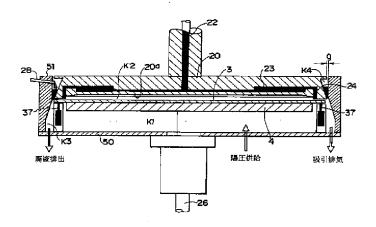
* * 37 環状ノズル (第3の吐出ノズル)

35 構造体





[図6]



[図7]

